# METHOD OF REDUCING METAL CONTENT IN FLUOROELASTOMER

Patent number:

WO9950319

**Publication date:** 

,1999-10-07

Inventor:

KITAICHI MASANORI (JP); SOGABE TOSHIO (JP);

SOTA TOMIZO (JP); KISHINE MITSURU (JP);

MORIKAWA TATSUYA (JP); TANAKA YOSHIYUKI (JP)

**Applicant:** 

KITAICHI MASANORI (JP); SOGABE TOSHIO (JP); SOTA TOMIZO (JP); DAIKIN IND LTD (JP); KISHINE MITSURU (JP); MORIKAWA TATSUYA (JP); TANAKA

YOSHIYUKI (JP)

Classification:

- international:

C08F14/18; C08F2/00; C08F6/00

- european:

C08F6/22

Application number: WO1999JP01517 19990324

Priority number(s): JP19980077235 19980325; JP19990005877 19990112

Also published as:

EP1097948 (A1) WO9950319 (A1) US6703461 (B1)

Cited documents:

JP9500163 WO9708239

JP9183812

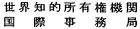
JP51031789 JP62285906

more >>

#### Abstract of WO9950319

A method of producing a fluoroelastomer reduced in the content of metallic ingredients; and a molded article comprising a fluoroelastomer sufficiently reduced in the content of metallic ingredients. The method comprises producing a fluoroelastomer without using a metal oxide through fluoromonomer polymerization, coagulation, and drying, wherein at least one of the starting materials excluding gaseous monomers contains substantially no metallic ingredients. The fluoroelastomer obtained by this method has a metal content of 50 ppm or lower.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide





# 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 C08F 14/18, 2/00, 6/00

A1 (11) 国際公開番号

WO99/50319

(43) 国際公開日

1999年10月7日(07.10.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/01517

(22) 国際出願日

1999年3月24日(24.03.99)

(30) 優先権データ

特願平10/77235 特願平11/5877 1998年3月25日(25.03.98) JP 1999年1月12日(12.01.99) JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) ダイキン工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP]

〒530-8323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

田中良幸(TANAKA, Yoshiyuki)[JP/JP]

北市雅紀(KITAICHI, Masanori)[JP/JP]

曾田富三(SOTA, Tomizo)[JP/JP]

森川達也(MORIKAWA, Tatsuya)[JP/JP]

曽我部利雄(SOGABE, Toshio)[JP/JP]

岸根 充(KISHINE, Mitsuru)[JP/JP]

〒566-8585 大阪府摂津市西一津屋1番1号

ダイキン工業株式会社 淀川製作所内 Osaka, (JP)

(74) 代理人

并理士 朝日奈宗太, 外(ASAHINA, Sohta et al.) 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目2番22号

NSピル Osaka, (JP)

(81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: METHOD OF REDUCING METAL CONTENT IN FLUOROELASTOMER

(54)発明の名称 含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法

#### (57) Abstract

A method of producing a fluoroelastomer reduced in the content of metallic ingredients; and a molded article comprising a fluoroelastomer sufficiently reduced in the content of metallic ingredients. The method comprises producing a fluoroelastomer without using a metal oxide through fluoromonomer polymerization, coagulation, and drying, wherein at least one of the starting materials excluding gaseous monomers contains substantially no metallic ingredients. The fluoroelastomer obtained by this method has a metal content of 50 ppm or lower.

· ÷ ;

BNSDOCID: <WO\_\_\_9950319A1\_I\_>



PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

i

### 明細書

# 含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法

# 技術分野

本発明は、金属含有量を低減させた含フッ素エラストマーをうる方法に関し、さらに、かかる方法によってえられる含フッ素エラストマーとその含フッ素エラストマーを含む組成物、および当該組成物からなる成形品に関する。

# 背景技術

従来から、含フッ素樹脂(プラスチック)に関しては、 クリーン度の厳しい要求のある半導体製造プロセスにおいて、薬液の配管、角槽、シリコンウェハのバスケットなど、半導体製品に直接的に影響を与える重要な部位に、 しかも大量に用いられてきたため、含フッ素樹脂の金属 成分含有量、TOC(全有機炭素)およびパーティクル の含有量を低減させることが積極的に行なわれている。

また、主としてビニリデンフルオライド(VdF)単位なはテトラフルオロエチレン(TFE)単位などからなる含フッ素エラストマーに関しては、フッ素ゴムの分野の用途や処理が適用され、加硫も含め含フッ素樹脂の分野と取り扱い方が大きいになっている。実際に加硫用組成物として用いるばあいには充填材、加硫促進剤、受酸剤などが配合されるため、しかも、ゴム材料については、主な用途がシール材であり、薬液の配管や角槽、バスケットなどと異なり、

or the second

極くわずかな接触部位に用いられてきたため、特に含フッ素エラストマーそのものの純度や不純物の存在が問題となることはほとんどなかった。

一方、含フッ素エラストマーは、優れた耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性を有するという点から、近年、半導体製造の分野において過酷な環境下において用いられる半導体製造装置用シール材として注目されている。

しかし、半導体製造の分野では高集積化および歩留まりの向上による半導体チップのコストダウンが急激に進んでおり、これにともない半導体製造を置に用いてもないのでおけても、金属成分、TOCおよびパーティクルを含まないこと、また半導体製造を置中にこれを対しないこと(いわゆる「クリーン化」)が強く要請されるようになり、シール材を各種溶剤で洗浄するという従来の方法だけでは不充分となってきた。

ても対策が必要となってきた。

一方、特表平8-506604号公報記載の技術によれば、加硫を金属化合物を用いず電子線を照射することにより行なっているが、この加硫物には依然として凝析剤に起因すると思われる金属成分が100ppmのオーダーで含まれている。

すなわち、従来の含フッ素エラストマーは、製造の際に重合開始剤、凝析剤などとして金属化合物を用いるために、金属成分を本質的に含有しうる。また、かかる含フッ素エラストマーを用いてなるシール材は、製造の際に、さらに加硫剤、加硫促進剤、受酸剤、充填剤などらいて金属化合物を用いるため、金属成分を含有し、さらにその表面にはパーティクルが存在することになる。

また、従来の金属成分含有量の評価は特定の溶出(抽出)条件下での溶出量で行なっているため、処理条件が異なれば、溶出量も大きく異なってくるのが現状である。

したがって、あらゆる環境や処理に対応できる、本質的に内部から金属成分が低減された含フッ素エラストマー、ならびに金属成分含有量が充分に低減された含フッ

素 エ ラ ス ト マ ー か ら な る シ ー ル 材 は え ら れ て い な い の が 現 状 で あ る 。

叙上の事実に鑑み、本発明の目的は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの金属成分含有量を内部から本質的に低減化する方法を提供し、さらに、結果として金属成分含有量が充分に低減された含フッ素エラストマーからなる成形品、特にシール材を提供することにある。

## 発明の開示

本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、金属化合物を用いない含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いるガス状のモノマーを除く原材料のうち少なくとも1つの原材料を、実質的に金属成分を含まない原材料とする含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

このばあい、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が重合媒体用の水であるのが好ましい。

また、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析用の凝析剤であるのが好ましい。

また、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析してえられる含水含フッ素エラストマーから水分を分離する際に添加する該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤であるのが好ましい。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素エラストマーの乳化重合を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を濾過して汚染物質を除去したのちに凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、金属元素を含まない酸を用いて含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマー、または該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離してえられるエラストマー凝析物を、清浄なガスを用いて乾燥させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

また、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、エラストマー凝析物と接触する部分がフッ素樹脂製フィルムまたはポリエチレン製フィルムをラミネートし

た容器、フッ素樹脂製容器およびポリエチレン樹脂製容器を用いる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する/。

また、本発明は前記方法のうち少なくとも2つの方法からなる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

本発明は、金属含有量が 5 0 p p m 以下、好ましくは 1 0 p p m 以下、より好ましくは 1 p p m 以下の含フッ素エラストマーに関する。

また、本発明は前記方法の1つまたは2つ以上を組合せてえられる金属含有量が50ppm以下、好ましくは10ppm以下の含フッ素エラストマーにも関する。

このばあい、含フッ素エラストマーが、テトラフルオロエチレン40~90モル%、式(1):

C F = C F - O R

(式中、R、は炭素数 1 ~ 5 のパーフルオロアルキル基、または炭素数 3 ~ 1 2 でかつ酸素原子を 1 ~ 3 個含むパーフルオロアルキル (ポリ) エーテル基) で表されるパーフルオロビニルエーテル 1 0 ~ 6 0 モル%、および硬

化 部 位 を 与 え る 単 量 体 0 ~ 5 モ ル % か ら な る の が 好 ま し い 。

また、前記含フッ素エラストマーが、ビニリデンフルオライド 3 0 ~ 8 5 モル%、ヘキサフルオロプロピレン 1 5 ~ 4 0 モル%およびテトラフルオロエチレン 0 ~ 3 0 モル%からなるのが好ましい。

また、前記含フッ素エラストマーが、ビニリデンフルオライド10~90モル%、式(1):CF2=CF-ORf(式中、Rfは前記と同様。)で表されるパーフルオロビニルエーテル10~40モル%およびテトラフルオロエチレン0~80モル%からなるのが好ましい。

また、前記含フッ素エラストマーが、ビニリデンフルオライド 4 0 ~ 9 0 モル%、パーフルオロ(メチルビニルエーテル)(PMVE) 3 ~ 3 5 モル%、ヘキサフルオロプロピレン 0 ~ 2 5 モル%、テトラフルオロエチレン 0 ~ 4 0 モル%、および硬化部位を与える単量体として含ヨウ素モノマー(IM) 0 . 0 0 5 ~ 1 . 5 モル%からなるのが好ましい(WO96/17877パンフレット参照)。ここで、含ヨウ素モノマーとしては、式(4):I(CH2CF2CF2O)m[CF(CF3)CF2O]nCF=CF2(式中、mは1~5 の整数であり、nは0~3 の整数である。)で表わされるヨウ素含有フッ素化ビニルエーテルを好ましく用いることができる。

また、前記含フッ素エラストマーが、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントと非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントを有する含フッ素多元セグメント化ポリマーであって、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン40~9

0 モル%、式(1):

 $C F_2 = C F - O R$ 

(式中、R, は前記と同様。)で表わされるパーフルオロピニルエーテル10~60モル%、および硬化部位を与える単量体0~5モル%からなり、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン85~100モル%、式(2):

 $C F_2 = C F - R_1$ 

(式中、 $R_{\mathfrak{g}}^{-1}$  は $CF_{\mathfrak{g}}$  または $OR_{\mathfrak{g}}^{2}$  ( $R_{\mathfrak{g}}^{2}$  は炭素数  $1\sim$ 5 のパーフルオロアルキル基))  $0\sim 1$  5 モル%からなるのが好ましい。

また、前記した各含フッ素エラストマーが、末端および/または側鎖にヨウ素および/または臭素を有するポリマー鎖を含むのが好ましい。

また、前記含フッ素エラストマーが、ニトリル基を含むのが好ましい。

また、本発明は、前記含フッ素エラストマーを含む組成物にも関する。

さらに、本発明は、前記組成物からなる成形品にも関する。

本発明は金属含有量が 5 0 p p m 以下、好ましくは 1 0 p p m 以下の成形品にも関する。

前記成形品は、半導体製造装置用シール材であるのが好ましい。

本発明はまた、含フッ素ポリマーの製造において、重合用原材料および生成物と接触する部分がフッ素樹脂でライニングされた装置を用いる含フッ素ポリマーの金属含有量低減化方法に関する。

このばあい、フッ素樹脂でライニングされた装置が、 重合槽およびそれに付属する撹拌翼、邪魔板などの重合 装置、凝析装置、洗浄装置、乾燥装置、およびこれらの 配管類であるのが好ましい。

また、フッ素 樹脂がテトラフルオロエチレン/パーフルオロ (アルキルビニルエーテル) 共重合体 (PFA) であるのが好ましい。

## 図面の簡単な説明

図1は、本発明による含フッ素エラストマーの製造方法の工程を説明するためのフローチャートである。

# 発明を実施するための最良の形態

まず、本発明の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法の基礎となる含フッ素エラストマーの製造方法の各工程を説明するためのフローチャートを図1に示す。 以下に、図1に示す含フッ素エラストマーの製造工程の順序にしたがって、本発明の方法を説明する。・

まず、本発明にもとづく含フッ素エラストマーの製造においては、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない。

すなわち、本発明は、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法に関する。

従来の含フッ素エラストマーの製造方法においては、 原材料として、過硫酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、硫酸第一鉄などの重合開始剤など、金属原子を含むものが 通常用いられていたため、えられる含フッ素エラストマ 一中に金属成分が含まれていた。そこで、本発明においては、特に前記課題を解決するため、全ての原材料に金属原子を含まない化合物を用い、さらに、少なくとも1つの原材料として、「実質的に金属成分を含まない原材料」を用いることを特徴とする。

本発明において、「実質的に金属成分を含まない」とは、金属化合物を用いないことは当然であるが、不純物としても金属化合物を徹底的に排除したものをいう。 具体的には、原材料の金属成分含有量が20ppb以下、好ましくは10ppb以下であることをいう。

ここで、本発明においていう金属成分とは、後述する方法により測定されるNa、K、Fe、Ni、Al、Cu、Cr、Zn、CaおよびMgをいう。

本発明においていう原材料とは、含フッ素モノマー、水、乳化剤、ヨウ素化合物などの連鎖移動剤、重合開始剤、アンモニアなどのpH調整剤、凝析剤などをいう。なかでも、含フッ素モノマー、乳化剤、ヨウ素化合物、重合開始剤、凝析剤については、金属をその構成する原子に含まないものを用いるのが重要である。

本発明において用いる含フッ素モノマーは、従来から用いられているものであればよいが、えられる含フトネエラストマーの安定性、非汚染性という点から、テトフルオロエチレン(TFE)、ビニリデンフルオライド(VdF)、ヘキサフルオロプロピレン(HFP)および式(1):CF₂=CF-OR、(式中、R、は炭素数1~5のパーフルオロアルキル基、または酸素原子を1~3個含む炭素数3~12のパーフルオロアルキルエーリ)エーテル基)で表わされるパーフルオロビニルエー

テルであるのが好ましい。

また、本発明の効果およびエラストマーの性質を損なわない範囲であれば、その他のモノマーを含んでいてもよい。その他のモノマーとしては、たとえば、硬化性を付与するプロピレン(Pr)、圧縮永久歪性を付与する式(4):I(C H₂C F₂C F₂O) m [C F (C F₃) C F₂O] n C F = C F₂(式中、mは1~5の整数であり、nは0~3の整数である。)で表わされるヨウ素含有フッ素化ビニルエーテル、また、特開平7-316246号公報に記載されている式(5):

 $C X_2 = C X - R_f^2 - C H R - I$ 

(式中、Xは水素原子、フッ素原子またはメチル基、Rは水素原子を有していてもよい直鎖状または分岐またロフルオローもしくはパーフルオロオキシアできる。はアフルオローもしくはパーフルオロオキシアできる。はアフィンなども使用できる。はいて下2=CHI、パーフルオロ(5ー3ーボーカー1ーペンテン)などがあげられる。有モノマーもあげられる。

$$CF_3$$
 $CF_2 = CF (OCF_2 CF_{2m} O + CF_{2m} CN)$ 

(式中、mは0~5、nは1~3)

$$CF_3 - CF \leftarrow CF_2 OCF \rightarrow_{\overline{n}} CF_2 OCF = CF_2$$

$$CN \qquad CF_3$$

(nは1~4)、

$$CF_2 = CFO (CF_2)_{\overline{n}} OCF (CF_3) CN$$

 $(n t 2 \sim 5)$ ,

$$CF_2 = CFO + CF_2 + CN$$

 $(n t 1 \sim 6)$ 

 $CF_2 = CF [OCF_2 CF (CF_3)]_n OCF_2 CF (CF_3) CN$ 

(nは1~2)、または

$$CH_2 = CFCF_2 O \leftarrow (CFCF_2 O) \xrightarrow{n} CF - CN$$

$$CF_3 \qquad CF_3$$

具体的に好ましいモノマーの組み合わせとしては、T FE/PAVE、VdF/HFP、VdF/TFE/H FP, VdF/PAVE/TFE, VdF/PMVE, VdF/HFP/PMVE、VdF/TFE/PMVE、 V d F / P M V E / H F P / T F E および T F E / P r / その他の単量体があげられる。TFE/PAVEのば あいの組成としては、40~90/10~60(モル%) であるのが好ましく、VdF/TFE/HFPのばあい の組成としては、3 0 ~ 8 5 / 0 ~ 3 0 / 1 5 ~ 4 0 (モ ル%) であるのが好ましく、VdF/PAVE/TFE のばあいの組成としては、10~90/10~40/0  $\sim$  8 0 (モル%) であるのが好ましい。また、 V d F /PMVEのばあいの組成としては、65~90/10~ 35 (EN%) 、VdF/HFP/PMVEのばあいの 組成としては、6 5 ~ 9 0 / 3 ~ 2 5 / 3 ~ 2 5 (モル%)、 V d F:/TFE/PMVEのばあいの組成としては、4

組成としては、6 5 ~ 9 0 / 3 ~ 2 5 / 3 ~ 2 5 (モル%)、 V d F / T F E / P M V E のばあいの組成としては、 4 0 ~ 8 0 / 3 ~ 4 0 / 1 5 ~ 3 5 (モル%)、 V d F / P M V E / H F P / T F E のばあいの組成としては、 4 0 ~ 8 0 / 3 ~ 2 5 / 3 ~ 2 5 / 3 ~ 4 0 (モル%) で あるのが好ましい。また、 T F E / P r / その他の単量 体のばあいの組成としては、 4 0 ~ 7 0 / 3 0 ~ 6 0 / 0 ~ 2 0 (モル%) であるのが好ましい。

(1) VdF/TFE (0~100/100~0)、特にVdF/TFE (70~99/30~1)、PTFE またはPVdF;

(2) エチレン/TFE/HEP(6~60/40~8 1/1~30)、3,3-トリフルオロプロピレン -1,2-トリフルオロメチル-3,3,3-トリフル オロプロピレン-1/PAVE(40~60/60~4 0):

- (3) TFE/CF<sub>2</sub> = CF-R<sub>f</sub><sup>1</sup> (非エラストマー性を示す組成範囲、すなわち、CF<sub>2</sub> = CF-R<sub>f</sub><sup>1</sup>が15 モル%以下) !
- (4) VdF/TFE/CTFE (50~99/30~0/20~1);
- (5) V d F / T F E / H F P (60 ~ 99 / 30 ~ 0 / 10 ~ 1);
- (6) I F V V / T F E (30 ~ 60 / 70 ~ 40);
- (7)ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE);
- (8) エチレン/ C T F E (30~60/70~40) などがあげられる。

本発明において用いる水は、金属含有量が前記範囲にあるものであればよいが、なかでも、金属およびTOC含有量が非常に少ない超純水を用いるのが好ましい。

本発明において用いる「実質的に金属成分を含まない」水は、たとえば逆浸透膜(RO)、限外濾過(UF)、マイクロフィルター(MF)などの膜分離法やイオン交換樹脂、活性炭吸着、UV酸化などの従来公知の方法を、多段利用も含めた連続プロセスとして用いることにより製造することができる。

超純水製造方法の一例としてはつぎのプロセスがあげられる。

- ①前処理システム(工業用水、地下水→前処理水): これは除濁および一次滅菌のために行なう。手段としては、凝析沈殿、凝集濾過、活性炭吸着、マイクロフィルター(MF)を用いる。
  - ② 一 次 純 水 シ ス テ ム ( 前 処 理 水 → 一 次 純 水 ) : こ れ は

脱塩のために行なう。手段としては、大半の溶解塩、有機物、微粒子および生菌の除去のために逆浸透(RO)を用い、精密脱塩のためにイオン交換樹脂を用いる。

③サブシステム(一次純水→超純水):これは一次純水中のイオンおよび微粒子の除去ならびに殺菌のために行なう。手段としては、有機物を分解するためにUV酸化を用い、コロイド状物質および高分子物質除去のために限外濾過(UF)を用い、精密脱塩のためにイオン交換樹脂を用いる。

本発明において用いる乳化剤としては金属原子を含まないものであれば特に制限はなく、たとえば、重合中におこる乳化剤分子への連鎖移動反応を抑制する観点から、フルオロカーボン鎖またはフルオロポリエーテル鎖を有するカルボン酸の塩類が好ましい。

具体的には、たとえば、パーフルオロオクタン酸アンモニウム、CF $_3$  (CF $_2$ ) $_n$ COONH $_4$  (n = 7 ~ 8)、CHF $_2$  (CF $_2$ ) $_n$ COONH $_4$  (n = 6 ~ 8)、C $_3$ F $_7$ OCF (CF $_3$ ) CF $_2$ OCF (CF $_3$ ) COONH $_4$  などがあげられる。

乳化剤の使用量は、添加された水の約 0 . 0 5 ~ 1 0 重量%であるのが好ましく、特に 0 . 2 ~ 5 . 0 重量% であるのが好ましい。

本発明において連鎖移動剤として用いるヨウ素化合物としては、金属原子を含まず、たとえば、1,3-ジョードパーフルオロプロパン、1,4-ジョードパーフルオロブタン、1,3-ジョード-2-クロロパーフルオロプロパン、1、5-ジョード-2,4-ジクロロパーフルオロペンタン、1,6-ジョードパーフルオロヘキ

サン、1,8-ジョードパーフルオロパーフルオロオクタン、1,12-ジョードパーフルオロパーフルオロドデカン、1,16-ジョードパーフルオロパーフルオロハーフルオロット・サデカン、ジョードメタン、1,2-ジョードエタンなどがあげられ、それぞれ単独で、または任意に組み合わせて用いることができるが、なかでも1,4-ジネードパーフルオロブタンを用いるのが好ましい。ヨウ素化合物の使用量は、ポリマーの分子量に影響するが、通常リマーの0.01~5重量%であればよい。

つぎに本発明においては、含フッ素モノマーの重合を行ない、乳化分散液を製造する。

用いる重合開始剤としては、金属原子を含まないものであれば特に制限はなく、たとえば、有機および無機の

過酸化物ならびにアゾ化合物があげられる。典型的なものとしては、過硫酸塩、過酸化カーボネート、過酸化エステルなどがあり、なかでも過硫酸アンモニウム(APS)を用いるのが好ましい。また、APSは単独で用いてもよいが、サルファイト、亜硫酸塩などの還元剤(金属原子を含まない)と組み合わせて用いてもよい。

また、このとき、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素モノマーの乳化重合を行なうことにより金属成分の混入を防ぐことができる。

したがって本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素モノマーの乳化重合を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

特に含フッ素モノマーを乳化重合させて含フッ素エラストマーを製造するばあい、重合中にフッ素イオンが発生し、重合装置の金属成分の溶出を促進させ、ポリマーに混入し、汚染するという可能性がある。

そこで、本発明においては、重合中に発生したフッ素 イオンを中和するために、乳化液を弱アルカリ性に保持 して含フッ素モノマーを乳化重合する。

乳化液を弱アルカリ性に保持する方法としては、金属化合物を用いないという点から、アンモニア水、炭酸アンモニウムなどのアンモニア化合物をpH調整剤として添加する方法があげられる。

ここで、「弱アルカリ性」とは、 p H 7 ~ 1 0 程度であることをいう。

なお、pH調整剤は、乳化液を製造する際に含フッ素 モノマーなどの成分と同時に混合すればよい。 本発明においてモノマーを組み合わせて用いるばあい、特にテトラフルオロエチレンとパーフルオロ(メチルビニルエーテル)の混合ガスを用いるばあい、カルプ(G・H・Kalb)ら、アドバンシーズ・イン・ケミストリー・シリーズ(Advances in Chemistry Series)129,13(1973)に記載されるように、爆発性を有するので、重合装置には着火源となるスパークなどが発生しないように工夫する必要がある。また、この点から、重合圧力はできる限り低く抑えるのが好ましい。

重合温度としては、通常乳化重合にて採用される温度であればよいが、ポリマーラジカルの安定性という点から、5~100℃であるのが好ましい。

また、重合圧力は、広い範囲で変化させることができる。一般には、7MPaより低い。重合圧力が高いほど重合速度が大きくなるため、生産性の向上の観点から、0.1MPa以上であるのが好ましい。

つぎに、本発明においては、前述のように乳化重合してえられる乳化分散液を凝析工程に供し、含水含フッ素エラストマーを製造する。

ここで本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、凝析剤として金属元素を含まない酸を用いて含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

本発明において用いる凝析剤としては、金属原子を含まない従来のものであれば特に制限はなく、たとえば、塩酸、硝酸、フッ酸、硫酸、トリフルオロ酢酸などの一般的な酸類があげられるが、汎用性や高純度化が可能なこと、使用量という点から、塩酸、硝酸、硫酸を用いるのが好ましい。

さらに、本発明においては、前記「実質的に金属成分を含まない」凝析剤のなかでも、半導体製造に用いられる高純度グレードの酸を用いるのが好ましい。

これにより、ポリマー中にとり込まれる金属成分量を 抑えることができるという効果がえられる。

なお、生産性の点で劣るものの、含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析法として凍結凝析法も採用することができる。

ここで、本発明においては、含フッ素エラストマーの 乳化分散液を凝析工程に供する前に、前記乳化分散液から汚染物質を除去(汚染物質除去工程)したのちに凝析を行なうことにより含フッ素エラストマーを製造するのが好ましい。

したがって本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液から汚染物

質を除去したのちに凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

含フッ素エラストマーの製造においては、凝析工程を 行なったのちに洗浄などにより汚染物質を除去するのは 効率に劣り、実際上困難である。したがって、凝析工程 の前に洗浄を行なうことにより汚染物質を除去するのが 好ましい。

ここでいう汚染物質とは、金属成分だけではなく、重合開始剤、pH調整剤、原料モノマー、乳化剤などおよびこれらの残渣、原料モノマーの低分子重合体などをいう。金属成分だけではなく、前記残渣をも除去するのは、凝析工程における酸類の使用量を低減すること、および凝析したエラストマーの洗浄工程を省略するためである。酸類を含有した含水含フッ素エラストマーを粉砕するためには、金属などの粉砕力のある刃物を用いる必要があり、これにより、金属分が溶出し、混入するためである。

汚染物質を除去する方法としては、半透膜による濾過洗浄により行なうのが好ましい。 具体的には、含フッ素エラストマーの乳化分散液を濾過して濃縮したのち、超純水などにより希釈し、かかる濃縮および希釈を繰り返せばよい。

濾過を行なう手段としては、特にセラミックフィルター、などの半透膜などの金属成分が溶出しにくい手段があげられる。これにより、良好な洗浄効果がえられる。

つぎに、本発明においては、含フッ素エラストマーの 乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非 水溶性溶剤を添加して水分を分離させる(水分分離工程)。 したがって、本発明は、含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤(以下、単に「非水溶性溶剤」ともいう)を添加して水分を分離させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法にも関する。

本発明の方法においては、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析して含水含フッ素エラストマーをうる処理法は、凝析剤として前述のものを用いるほかはで素エラスはは、なられた含水含フッ素エラストマーの水分中に含まれうる金属成分、TOC、パーティクル、凝析剤などがエラストマーから水分を分離する。

本発明においては、含水含フッ素エラストマーから水分を分離する方法としては、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加することにより行なう。さらに、この操作は繰り返して行なうことにより効果が大きくなる。

かかる非水溶性溶剤としては、たとえば、1, 1-ジ クロロ-1-フルオロエタン(H C F C - 1 4 1 b)、 1, 1, 1, 2, 2-ペンタフルオロ-3, 3-ジクロ ロプロパン(H C F C - 2 2 5 c a)、1, 1, 2, 2, 3-ペンタフルオロ-1, 3-ジクロロプロパン(H C F C - 2 2 5 c b)、パーフルオロヘキサン、パーフル オロ(1-クロロー4ーヒドロブタン)などがあげられ、なかでも、後の除去の容易性からHCFC-141bを用いるのが好ましい。また、この溶剤も金属成分を含まないことが重要である。これにより、水溶性物質の除去が可能となるという効果がえられる。

従来の含フッ素エラストマーの製造においては、含水含フッ素エラストマーを乾燥させる際、通常の空気には、SiO2、金属ないのパーティクルが含まれているため、乾燥後の含フッ素エラストマーの表面に前記パーティクルが付着して含まう。そこで、本発明においては、清浄ガスを用いて含フッ素エラストマーを乾燥させる。また、減圧して乾燥するのが好ましい。

本発明における清浄ガスとは、 0 . 2 μ m 以上のパーティクルが 1 0 0 0 0 個以下、好ましくは 1 0 0 個以下であるガスをいう。

ここで用いることのできるガスの種類としては、特に制限はなく、たとえば、空気、チッ素、アルゴンなどの

不活性ガスなどがあげられるが、通常の空気中に含まれるTOC源やアンモニア化合物を取り除くという点から、ケミカルフィルターにて処理した空気、または窒素ガスやアルゴンガスを用いるのが好ましい。

また、清浄ガスをうる方法としては、通常用いられる PTFE製フィルターやHEPAフィルターを用いるの が一般的である。

これにより、パーティクルの削減や金属含有量の低減を図ることができるという効果がえられる。

上述のように、本発明においては、前述したそれぞれ 1つの方法によって含フッ素エラストマーの金属含が、ことができるが、ことができるができるがいたより、たららにより、たららにより、たっとができ、かっ金属含有量である。するとができる。するとができる。するとができる。するとができる。するとができる。するとができる。するとがらなる。なりなくとも2つの方法からなる含フットマーの金属含有量低減化方法にも関する。

金属含有量が1 p p m以下というように非常に低減化された含フッ素エラストマーを製造するためには、図1に示すすべての工程を金属の混入を防ぐというして思想で設計する必要がある。特に好ましい例として構成元素として含まない化合物とし、特にポリマーと接触の多い、純水や凝析剤には高純度に精製されたものを使う。また、重合工程、凝析工程においては、乳化液や含水がし、金属の混入を抑える。また、乾燥工程においてもポ

リマーが接触する部分をフッ素樹脂フィルムやフッ素樹脂製のトレイにすることで金属含有を防ぐことができる。また、乾燥には、パーティクルを含まないクリーンなエアーや不活性ガスを用いることなどがあげられる。

またこのようにして得られたクリーンな含フッ素エラストマーを非常に金属含有量の少ない充填剤を配合して得られるフッ素ゴム成形品は、成形品自体としても非常に金属含有量が低減されており、半導体シール材として従来にない非汚染性を示す。

さらに本発明は、前述のようにしてえられる含フッ素 エラストマーを含む組成物にも関する。このばあい、本 発明の方法によりえられた金属成分含有量の低減化され た含フッ素エラストマーとともに用いるほかの成分とし ては、えられる成形物の金属成分含有量、表面のパーティクル数、TOCが増加しないように、金属原子を含まないものであるのが好ましい。

ほかの成分としては、加硫剤、加硫促進剤、充填材などがあげられる。

加 硫 剤 と し て は 、 ヨ ウ 素 ま た は / お よ び 臭 素 を 有 す る エラストマーの場合、たとえばジクミルパーオキサイド、 ベンゾイルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5 - ビス ( t - ブチルパーオキシ) ヘキサン、 2 , 5 - ジ メチル - 2 , 5 - ビス ( t - ブチルパーオキシ) ヘキシ ン - 3 、ビス ( 2 , 4 - ジクロロベンゾイル)パーオキ サイド、t-プチルクミルパーオキサイド、t-プチル パーオキシベンゼン、1, 1 - ビス ( t - ブチルパーオ キ シ ) - 3 , 5 , 5 - ト リ メ チ ル シ ク ロ へ キ サ ン 、 2 , 5-ジメチルヘキサン-2,5-ジヒドロキシパーオキ サイド、α, α´ービス(tープチルパーオキシ)-p - ジイソプロピルベンゼン、2,5-ジメチル-2,5 - ジ(ベンゾイルパーオキシ)へキサン、 t - ブチルパ ーオキシイソプロピルカーボネートなどの有機過酸化 物;ニトリル基を有するエラストマーの場合、たとえば、 2,2-ビス-(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス-(3,4-ジ アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビ ス(3-アミノ-4-メルカプトフェニル)ヘキサフル オロプロパンなどの2官能化合物などがあげられる。

また、加硫促進剤としては、ヨウ素または/および臭素を有するエラストマーの場合、たとえば、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート(TAIC)、

トリアリルトリメリテート、ジアリルフタレートなどの多価アリル化合物、含フッ素トリアリルイソシアヌレート、CH<sub>2</sub>=CH(CF<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH=CH<sub>2</sub>(n=2~6)で示されるビスオレフィンなどの含フッ素多官能オレフィンなどの含カッ素多官能オレフィンなどの含カッ素を開発した。なかでも、加硫性、えられる加硫物の物性面という点から、トリアリルイソシアスレート、含フッ素トリアリルイソシアスレート、含フッ素トリアリルイソシアスレート、含フッ素トリアリルイソシアスレート、はこれらの併用系を用いるのが好ましい。

また、充填材としては、たとえば、カーボンブラック (特に黒鉛化カーボンブラック)や酸化ケイ素、酸化カーボンブラック素樹脂などの有機フィラー、フッ素樹脂などの有機フィラーなどがあげられる。なかでも、クリーン性という点から、黒鉛化カーボンブラック、高純度合成石英シリカ、ポリテトラフルオロエチレンなどを用いるのが好ましい。前記組成物は、各成分を常法によって混合することによりえられる。また、加硫については、常法により行な

半導体関連製造装置などの非汚染性を強く求められる 用途の場合、架橋剤などを添加せずに高エネルギー線架 橋をするのが好ましい。架橋源としては、α線、β線、 γ線、X線などの放射線、電子線、紫外線などが用いら れる。

予備成形体に照射される高エネルギー線は、たとえば電子線の場合、照射線量は5~500kGyが好ましく、さらに好ましくは10から300kGyである。5kGyより少ないと放射線の照射による機械的強度の改善が不充分となり、500kGyより多いとポリマーの崩壊が進行し、分子間結合が一部切断されて、成形体の機械

的強度が低下する。また機械的強度の改善のためには線量率は500kGy/h以上が好ましく、さらに好ましくは1000kGy/h以上が良い。

できている。 一できないできる。 を発明による含アッ素エラス体製造装置用の成成でできない。 できないでは、カーリングシールをです。 では、カーリング・ステリング・ステリング・ステリング・ステリング・ステリング・ステリング・ステリング・ステリング・ステリンができる。 できるたでり、カーリンができる。 できるたでり、などのできる。 できる。のできる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 に、おいるに、たいないのできる。 でいるなができる。 に、おいるに、たいないのできる。 に、たいるなどができる。 でいるなができる。 でいるなどのいるなどのに、は、はいるにのいる。 でいるなどのいるなどのいるなどのいる。 でいるなどのいるなどのいるなどのいる。 できる。 できる。

なお、本発明でいう半導体製造装置は、特に半導体を製造するための装置に限られるものではなく、広く、液晶パネルやプラズマパネルを製造するための装置など、高度なクリーン度が要求される半導体分野において用いられる製造装置全般を含むものである。

具体的には、次のような半導体製造装置が例示される。
(1) エッチング装置

ドライエッチング装置 プラズマエッチング装置 反応性イオンエッチング装置 反応性イオンビームエッチング装置 スパッタエッチング装置 イ オ ン ビ ー ム エ ッ チ ン グ 装 置 ウ ェ ッ ト エ ッ チ ン グ 装 置 ア ッ シ ン グ 装 置

(2) 洗浄装置

乾式エッチング洗浄装置 UV/O3洗浄装置 イオンビーム洗浄装置

レーザービーム洗浄装置

プラズマ洗浄装置

ガスエッチング洗浄装置

抽出洗浄装置

ソックスレー抽出洗浄装置

高温高圧抽出洗浄装置

マイクロウェーブ抽出洗浄装置

超臨界抽出洗浄装置

(3) 露光装置

ステッパー

コータ・デベロッパー

(4) 研磨装置

C M P 装置

(5)成膜装置

C V D 装置

スパッタリング装置

(6) 拡散・イオン注入装置

酸化拡散装置

イオン注入装置

以下に実施例を用いて本発明を説明するが、本発明はこれらのみに制限される物ではない。

### 実施例1

(1) 原材料選定工程

以下に、各成分として用いたものを以下に示す。また、これらの金属成分含有量を表1に示す。

含フッ素モノマーA:テトラフルオロエチレン(TFE) 含フッ素モノマーB:CF<sub>3</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>O(CF(CF<sub>3</sub>) CF<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>CF=CF<sub>2</sub> で示されるパーフルオロアル キルビニルエーテル (PAVE)

含ヨウ素モノマー: I C H<sub>2</sub> C F<sub>2</sub> C F<sub>2</sub> O C F = C F<sub>2</sub>( I M )

ョウ素化合物: 1,4-ジョードパーフルオロブタン(DI)

乳化剤: パーフルオロオクタン酸アンモニウム。乳化剤 中の金属成分含有量は、Fe: 8 1 0 0 p p b、N a: 6 0 0 p p b、K: 2 0 0 p p b であった。

重合開始剤:過硫酸アンモニウム(APS)

p H 調整剤: 炭酸アンモニウム

凝析剤: 塩酸(MERCK社製の半導体グレード HCl、Suprapur)。 HCl中の金属成分含有量は、Fe: 4ppb、Na: 4ppb、K: 1ppbであった。

非水溶性溶剤: 1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン (HCFC-141b)。HCFC-141b中の金 属成分含有量は、Fe:3ppb、Na:1ppb以 下、K:2ppb以下であった。

純水:前述した方法によりえたもの。純水中の金属成分含有量は、Fe:2ppb、Na:0.7ppb、K:0.2ppb以下であった。

### (2)乳化液製造工程1(予備乳化)

純水 2 5 4 0 g、乳化剤(パーフルオロオクタン酸アンモニウム) 1 1 4 g、含フッ素モノマー(PAVE) 2 2 8 4 g、含ヨウ素モノマー(IM) 2 2 . 7 g、 p H調整剤(炭酸アンモニウム) 1 2 . 7 g、ヨウ素化合物(DI) 3 . 5 gを5 リットルの P F A 製ビーカーに入れ、乳化機(ヤマト科学(株) 製の U L T R A - D I S P E R S E R M O D E L L K - 4 1 )を用いて、6 0 秒間混合し、体積平均粒径 2 μ m に乳化させた予備乳化液をえた。

### (3) 乳化液製造工程2(強制乳化)

えられた予備乳化液を、直ちに、強制乳化機(マイクロフルーイディクス インターナショナル コーポレーション(Microfluidics International Corporation)社製のMicrofluidizer Models M-210E/H)を用い、乳化圧力1000kgf/cm²Gで乳化し、乳化液をえた。

ここで、乳化液の乳化粒径を日機装(株)製の粒度分析計UPA9340を用いて測定したところ、体積平均粒径は181nmであった。また、体積平均粒径と乳化液中に含まれるPAVEの量とから計算できる水1ml当たりの粒子数は1.55×10<sup>14</sup>個であった。乳化液のpHは8.9であった。

#### (4) 乳化重合工程

内容量 6 0 0 0 m 1 のステンレススチール製の耐圧反応 槽にえられた乳化液 4 3 5 0 g と亜硫酸アンモニウム (水和物) 6 . 6 g を入れ、内部空間をチッ素ガスで充 分 置 換 し た の ち 、 撹 拌 下 、 1 5 ℃ に し て 真 空 引 き し 、 含 フッ素モノマー (TFE) のガスで4.7 kgf/cm <sup>2</sup> G まで加圧した。重合開始剤(APS)の 0 . 88重 量%水溶液5.4m1を圧入すると、直ちに重合反応が 始まって圧力降下が起こった。 3 . 0 k g f / c m 2 G まで圧力が降下したとき、3.0kgf/cm<sup>2</sup>Gの圧 力を維持すべくTFEガスを59g追加仕込みした。追 加仕込みを終えると圧力降下が起こり、2.0kgf/ c m<sup>2</sup>G まで圧力降下したところで2.0 k g f / c m<sup>2</sup> Gの圧力を維持すべくTFEガスを95g追加仕込みし た。この追加仕込みを終えると圧力降下が起こり、1. 0 k g f / c m<sup>2</sup>G まで圧力降下したところで1.0 k g f / c m 2 G の 圧 力 を 維 持 す べ く T F E ガ ス を さ ら に 9 8 g 追加仕込みした。この追加仕込みを終えた時点で 放圧し、重合を停止させた。なお、重合中には3時間ご とにAPSの0.88重量%水溶液を5.4m1ずつ圧 入した。この結果として5049gの水性分散液をえた。 重 合 時 間 は 1 7 時 間 7 分 で あ っ た 。 ま た 、 え ら れ た 水 性分散液の固形分濃度は23.2重量%で、pHは8. 3 であり、体積平均粒径は191nm、体積平均粒径、 固形分濃度、重合終了時に残存するPAVEから計算さ れた水 1 m l 当 た り の 粒 子 数 は 1 . 3 4 × 1 0 1 4 個 で あ った。水性分散液中の金属成分含有量を表1に示す。

### ( 5 ) 汚染物質除去工程

前記(4)と同様の方法で反応スケールを約10倍とした重合でえた水性分散液20kgを140kgの水で希釈した。セラミックフィルター(U.S.FILTER社製、フィルター長さ:836mm、フィルター孔径:

2 0 0 n m 、 マ ル チ ル ー メ ン ( レ ン コ ン 型 ) 内 径 : 直 径 4 m m × 1 2 穴 、 使 用 本 数 : 1 0 本 ) の 両 側 に 加 圧 可 能 な 夕 ン ク ( 容 量 3 0 0 リ ッ ト ル ) を 2 基 も つ 装 置 に お い て 、 一 方 の タ ン ク 内 に 希 釈 し た 水 性 分 散 液 を 仕 込 ん だ 。 その後、希釈した水性分散液を仕込んだタンクをチッ素 ガスで 1 . 5 k g f / c m <sup>2</sup> G に 加 圧 し 、 他 方 の 空 の タ ン ク を 1 . 3 k g f / c m <sup>2</sup> G に 加 圧 し 、 そ の 差 圧 に て フィルター内に希釈させた水性分散液を通過させて濾過 を行なった。一方のタンク中の水性分散液がなくなった 時点で両タンクの圧力設定を逆にし、逆方向に水性分散 液を移動させた。水性分散液が特定の濃度(エラストマ 一 含 有 量 6 . 0 重 量 % ) に ま で 濃 縮 さ れ た の ち に 、 再 度 水 を 1 4 0 k g 添 加 し た 。 こ の 工 程 を 2 1 時 間 か け て 5 回繰り返した。計算された希釈倍率は612倍であった。 最終的にえられた洗浄後の水性分散液は84.3リット ル で あ り 、エ ラ ス ト マ ー 含 有 量 は 6 . 0 重 量 % で あ っ た 。 また、アンモニアイオンメーターで測定したアンモニウ ムイオン濃度は77ppmであり、濾液の濃度から計算 した乳化剤に基づくアンモニウムイオン濃度は67pp m 、 そ の ほ か の ア ン モ ニ ウ ム イ オ ン 濃 度 は 1 0 p p m で あった。

洗浄後の水性分散液中の金属成分含有量を表1に示す。(6)凝析工程

(5)でえられた洗浄後の水性分散液19.3gを水0.7gで希釈し、PFA製ビーカーに入れた凝析剤(MERCK社製 Suprapur: 半導体グレードHC1の3.5%水溶液)12gに滴下し凝析を行なって、含水含フッ素エラストマーをえた。

### (7) 水分分離工程

えられた含水含フッ素エラストマーを非水溶性溶剤(ダイキン工業(株)製のHCFC-141b)14gに撹拌しながら浸した。その後、上層の水、およびHCFC-141bを除去した。このことを3回繰り返し含水含フッ素エラストマー中の水分および未反応PAVEを除去し、溶剤に膨潤したエラストマーをえた。使用した合計56gのHCFC-141bを46g回収した。その回収溶剤中には乳化剤が凝析剤によりカルボン酸にたののしたものが0.028g、さらに重合工程での未反応PAVE(1.290g)のうち1.225gが含まれていた。

#### (8)乾燥工程

えられた溶剤を含むエラストマーを耐熱性HEPAフィルターを用いて庫内をクラス100の環境にしているオープン中150℃で12時間乾燥を行なった。えられたポリマーの金属成分含有量を表1に示す。

### [評価]

まず、本発明において用いる金属成分含有量の分析法について説明する。

金属分を測定するには最終的には液体中で測定し、超純水、分散液などはマイクロピペットを用い、10μ1を直接フレームレス原子吸光分光光度計(偏光ゼーマン原子吸光分光光度計 Z-8100、(株)日立製作所製)に導入し、測定する。測定の検出限界を表1に示す。フッ素ポリマー中の金属分は、1ppm以上含むばあいには、測定する固体をまず白金製の蒸発皿(白金純度99・9%)に入れ、電気炉によりポリマーを500℃

にて30分間灰化した後に残存する微量金属を高純度塩酸(35%)に溶解して、フレームレス原子吸光分光光度計で吸光度を測定した。

含有金属量が1 p p m 以下の超微量のばあいには、W O 9 4 / 2 8 3 9 4 記載の測定方法を用いて測定した。 具体的には、定量すべき金属を含む所定量のサンプルをキュペット内で約100℃の灰化温度で約240秒間の灰化時間を含む灰化条件で灰化した後、そのままフレームレス原子吸光分光光度計で吸光度を測定した。

なお上記の(4)でえられた水性分散液 2 3 . 5 gを水 6 7 . 5 gで希釈し、エラストマー含有量を 6 . 0 重量%にした。この希釈水性分散液を用いること以外は上記の(6)~(8)と同様に凝析、脱水、乾燥し、エラストマーをえた。えられたエラストマーの抽出アンモニウムイオン量は 7 5 1 p p b であった。

また、凝析剤として、3.5%試薬特級グレードHC 1水溶液12gを用いること以外は上記の(6)~(8) と同様の凝析、脱水、乾燥し、エラストマーをえた。えられたエラストマーの金属含有量は、Fe860ppb、 Na1070ppb、K150ppbであった。 実施例2(PFAライニング容器などを用いることの効

実 施 例 2 ( P F A ラ イ ニ ン グ 容 器 な ど を 用 い る こ と の 効 果)

重合槽内部の接液部(槽内、撹拌翼、温度計さや管)に厚さ 2 0 0 μ m の P F A ライニングを施した着火源をもたない 3 リットルの反応装置の中へ水 1 . 5 リットル、パーフルオロノナン酸アンモニウム( C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> C O O N H <sub>4</sub>) 1 5 g を仕込んだ。 つぎに重合槽内部から酸素を除去するため撹拌しながら T F E 加圧、排出を繰り返し

行なった。槽内を50℃に温調後、パーフルオロメチル ピニルエーテル (PMVE)、TFEを圧入し、圧力8 kgf/cm<sup>2</sup>G、混合ガス組成比TFE/PMVE= 1 (mol%) に調整した。過硫酸アンモニウム (AP S ) 3 0 m g を 5 m l の 純 水 に 溶 解 し N 。 で 圧 入 し 、 重 合開始し、槽内圧力が7kgf/cm2Gになると1, 4 - ジョードパーフルオロブタンを圧入し、TFE/P MVE=62/38 (mol%) の比率にてそれぞれの ガスを追加し、元の圧力まで昇圧した。その後、圧力が 7 k g f / c m <sup>2</sup> G に な る 毎 に 同 様 の 昇 圧 を 繰 り 返 し た 。 さらにAPSを3時間毎に10mgを5mlの純水に溶 解しN。で圧入することを繰り返し15時間後に未反応 ガスを排出し、重合を終了した。えられた水性分散液の エラストマー含有率は27.1%、pH=2.5であっ た。えられた水性分散液中の金属含有量は、Fe:70 ppb、Na:4ppb、K:2ppb以下であった。 えられたポリマーの金属成分含有量を表1に示す。

なお、ステンレススチール製の重合槽を用いたほかは上記と同様の方法にて重合を行なった。 えられた水性分散液のエラストマー含有率は26.8%で、pHは2.7であった。この水性分散液中の金属含有量は、Fe:250ppb、Na:10ppb、K:6ppbであった。

実施例3(水性分散液の洗浄方法の他の態様)

実施例 1 の (4) でえられた水性分散液 6 0 gをゲルセロファン半透膜に仕込み、純水 6 リットルにその半透膜を 2 4 時間浸したのち、新しい水に入れ替えた。この操作を 1 0 回繰り返した。アンモニアイオンメーターで

測定した水性分散液中のアンモニウムイオンは、40ppbであった。

えられた水性分散液を実施例 1 の ( 6 ) ~ ( 8 ) と同様に処理し乾燥エラストマー 1 3 g をえた。 そのエラストマーのアンモニウムイオン抽出量は 8 0 p p b であった。

荗

							1		,			
				俄	属 及,	成分含有	岬	( p d d )				NH4 +
		Яe	Na	×	Cr	Ë	Cu	Ca	Mg	Zn	A1	(mdd)
	4 2 2	2	0.7	< 0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1
	6.5世	8100	009	200	ı		1	l	١	ı	1	ţ
底 ‡	47亿列 (北海休田)	4	4	-	1	1	1	1	l	ı	1	
2 英	1101 (十种平元)	70	790	160		1	1		1	ı	ı	ļ
	HCFC - 141b	3	< 1	< 2	< 1 ×	< 1 < 1	\ \ \	< 1 × 1	< 1	< 2	< 5	ì
	四 化 市 今 後 の 今 對 孩 (実 施 例 1)	120	က	< 2	15	∞	75	\ \ 1	< 1	27	< 5	3370
<u> </u>	れに重日欧ジルボボー 本海後の分散液(実体	270	14	9	18	26	120	< 1	8	70	< 5	77
	重合槽に PFA ライボール A フィルボール A フィルギール A フィルギール A フィルギール A フィルギール A フィー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー	20	4	< <b>2</b>		ı	1	1	l	1	l ,	ı
下	おもいの方取成分散を削削を	\ <u>\</u>	^ 1	< 2	\ 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 2	1
<del> </del>	半導体グレードHC1を用いて	440	4	< 2 < 5	38	20	360	∞	15	20	വ	l
~	たホリマー(美畑四1)											

BNSDOCID: <WO\_\_\_9950319A1\_I\_>

#### 実施例4

## (1) 乳化重合工程

内容量6000mlのステンレススチール製の耐圧反 応 槽 に え ら れ た 超 純 水 2 リ ッ ト ル 、 乳 化 剤 ( C , F , , C OONH<sub>4</sub>)20g、pH調節剤(炭酸アンモニウム) 1 8gを入れ、内部空間を窒素ガスで充分置換したのち、 6 0 0 r p m で 撹 拌 下 、 5 0 ℃ に 昇 温 し 、 テ ト ラ フ ル オ ロエチレンとパーフルオロ(メチルビニルエーテル)の 混 合 物 ( T F E / P M V E = 2 0 / 8 0 、 モ ル 比 ) を 内 圧が 1 2. 0 k g f / c m <sup>2</sup>G まで圧入した。 重合開始 剤として過硫酸アンモニウム(APS)の186mg/ ml水溶液2mlを窒素圧で圧入すると、直ちに重合反 応が始まって圧力降下が起こった。11.0kgf/c m²Gまで圧力が降下したとき、ジョウ素化合物である I ( C F 2) 4 I を 4 . 0 g 圧 入 し 、 つ い で T F E を 自 圧 に て 1 9 . 0 g 、 P M V E を 2 3 . 0 g プランジャーポン プにて圧入し、昇圧昇温を繰り返した。TFEおよびP M V E の 合 計 仕 込 量 が 4 3 0 g 、 5 1 1 g 、 5 9 6 g お よび697gに達した時点でヨウ素化合物であるICH <sub>2</sub> C F <sub>2</sub> C F <sub>2</sub> O C F = C F <sub>2</sub> を 各 1 . 5 g 圧 入 し た 。 な お 、 重合中には、反応開始後、12時間毎に35mg/ml のAPS水溶液2m1を窒素ガスで圧入した。

重合反応開始から34時間後、TFEとPMVEの合計仕込み量が860gになった時点でオートクレープを冷却し、未反応モノマーを放出して固形分濃度30.0 重量%の水性分散液を得た。

# (2)凝析工程

(1) でえられた水性分散液4.0gを超純水15.

7gで希釈し、PFA製ビーカーに入れた凝析剤(MERCK社製 Suprapur:半導体グレードHCIの3.5%水溶液)12gに滴下し凝析を行なって、含水含フッ素エラストマーをえた。

## (3)乾燥工程

えられた溶剤を含むエラストマーを、フッ素樹脂(PFA)製フィルム上におき、耐熱性HEPAフィルターを用いて庫内をクラス100の環境にしているオーブン中150℃で12時間乾燥を行なった。えられたエラストマーのムーニー粘度(ML1+10(100℃))は61であった。¹9F-NMR分析の結果、このエラストマーのモノマー単位比は、TFE/PMVE=60.3/39.7であり、ヨウ素含量は0.31重量%であった。

得られたエラストマーの金属含有量を実施例 1 と同様にして調べた結果、Fe=80prb、Cr=10ppb、Ni=10ppb、Cu=100ppb、Na=560ppb、K=200ppb、Ca=70ppb、Mg=80ppb、Zn=40ppbおよびAl=140ppbであり、合計1290ppbであった。 実施例 5

実施例 4 で得られたクリーン化されたフッ素系エラストマーを用い、表 2 に示す組成で 4 種類の架橋性エラストマー組成物を調製した。ここで用いる充填剤はいずれも金属含有量を低減させたものである。このエラストマー組成物を 1 6 0 ℃ 1 0 分間プレス架橋(一次架橋)してOロッグ(AS-5 6 8 A-2 1 4)を作製した。

ついで、この〇ーリングに次の洗浄方法を順次施した。 (H,SO4/H2O2混合液での洗浄)

O-リング(AS-568A-214)をH2SO4/H2O2(11/1)混合液を用いて100℃にて15分間洗浄したのち、50%HF水溶液を用いて25℃にて15分間洗浄した。その後、超純水を用いて100℃にて2時間洗浄し、さらに20m1/分高純度窒素ガス気流下(容積40×40×40cm)180℃で24時間加熱して水分を除去した。この<math>O-Uングの常態(25℃)物性および圧縮永久歪みをJIS K6301にしたがって測定した。結果を表2に示す。得られた最終製品の金属含有量を調べた。結果を表3に示す。

CV
表
יידויו

		含フッ素エラン	含フッ素エラストマー組成物	
	A (透明)	B (黑系)	C (白系)	D (乳白色系)
7 … 要系エラストマー(1)(g)	100	100	100	100
	2.0	2.0	2.0	2.0
パーヘキサ 2.5B(3)(g)	0.5	0.5	0.5	0.5
1 1 1 1 1 (g)	ı	10.0	1	1
1 - FX(5) (g)	ı	1	10.0	I
NTDVLSF(6) (g)		1	ì	25.0
<b>常题物性(25℃)</b>			and Appropriate Section 1	,
100%引張応力 (MPa)	1.7	9.1	7.0	4.4
引張強さ (MPa)	10.2	22.1	20.8	18.0
伸び(%)	300	250	240	200
硬度 (ShoreA)	65	82	7.7	7.0
圧縮永久歪み(%)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,
200℃70時間	13	13	17	15

TFE/PMVE/IM 共重合体

ブチルパーオキシ) ヘキサン

トーカブラック # 3885 トリアリルイソシアヌレート 日本油脂株式会社製 2,5 - ジメチルー 2,5 - ジ(t 東海カーボン株式会社製黒鉛化カーボンブラック 株式会社龍森製超高純度合成石英球状シリカ ダイキン工業株式会社製低分子量 P T F E (2) (3) (4) (5) (6)

表 3

A 2		含有量	(ppm)	
金属	A	В	С	D
Fe	1.0	3.0	0.3	0.3
Cr	0.1	0.5	2.0	0.1
Ni	0.1	2.0	0.3	0.1
Cu	0.1	1.0	8.0	0.1
Na	0.9	2.0	2.0	1.0
K	0.2	5.0	3.0	0.9
Ca	0.4	10.0	5.0	0.2
M g	0.2	4.0	1.0	0.2
Al	0.1	9.0	2.0	0.6

また、得られた最終製品〇一リングについて、以下に示す方法にて金属抽出量を調べた。結果を表 4 および表 5 に示す。ポリマーと充填剤ともにクリーン化されることによって、成形品自身の金属量をはじめて低減化できる。

- (1) 予め充分洗浄したPFA製容器(フタ付き)に抽出用薬液を所定量入れる。
- (2)使用する抽出用薬液(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(4/1)または50%HF)は、半導体用グレードを用いる。
- (3) 試料 O-1 ングをそれぞれの薬液中に浸漬( $H_2$  S  $O_4$  /  $H_2$  O 2 混合物では 2 5  $\mathbb{C}$  1 4 日間、 5 0 % H F では 2 5  $\mathbb{C}$  2 4 時間)し、密封の後、所定の温度で保持する。その際試料を浸漬せず薬液のみで同様の保管をし

たものを対照とする。

(4)任意の期間保管した後、薬液中の含有金属濃度をH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>についてはICP-MS(セイコー電子(株)製のS'PQ9000)で、50%HFでは原子吸光測定装置((株)日立製作所製のZ-8000)で測定する。

(5)次式により〇一リングからの抽出金属を算出する。

表4はH2SO4/H2O2混合液による金属抽出量を、表5は50%HFによる金属抽出量を示す。

表 4

		抽出量	(ppb)		検出限界
金属	A	В	С	D	(ppb)
Fe	10	20	10	10	. 5
Ni	40	ND	10	400	0.9
Cu	3	2	8	2	0.1
Na	1	30	10	5	0.2
К	ND	ND	ND	ND	10
Ca	ND	ND	ND	ND	5
Мg	20	4	4	4	0.1
Al	3	2	4	10	0.1

表 5

A R		抽出量	(ppb)		検出限界
金属	A	В	С	D	(ppb)
Fe	5.0	50.0	20.0	9.0	5
Cr	3.0	ND	3.0	2.0	2
Ni	ND	ND	ND	ND	4
Cu	ND	ND	ND	ND	0.1
Na	1.0	ND	2.0	1.0	0.5
K	ND	ND	ND	1.0	0.7
Ca	ND	7.0	20.0	30.0	7
Mg	1.0	20.0	7.0	1.0	0.2
Zn	30.0	20.0	30.0	8.0	0.6
Al	ND	ND	ND	ND	2

# 実 施 例 6

# (1) 乳化重合工程

 二ウムの34.3mg/mlの濃度の水溶液を10ml と過硫酸アンモニウム(APS)の135mg/mlの 濃度の水溶液10mlを順次それぞれ別々に窒素圧で圧 入して反応を開始した。

重合の進行により内圧が、7.0kg f / c m² G まで降下した時点でCF₂=CFOCF₂CF(CF₃)OCF₂ C F 2 C N(C N V E)3gを窒素圧にて圧入した。ついで圧力が8.0kg f / c m² G になるように、TFEとPMVEを4.7g/5.3gの比でそれぞれ自圧にて圧入した。以後反応の進行に伴ない同様にTFE、PMVEを圧入し7~8kg f / c m² G のあいだで、昇圧、降圧を繰り返すとともに、重合の開始から2.5時間後と5時間後に亜硫酸アンモニウムの34.3mg/mlの濃度の水溶液10mlを順次それぞれ別々に窒素圧で圧入した。

重合の開始から8時間後、TFEおよびPMVEの合計仕込み量が70gになった時点でオートクレープを冷却し、未反応モノマーを放出して固形分濃度6.1重量%の水性分散体1130gを得た。

# (2)凝析工程

(1) でえられた水性分散体のうち1000gを水3 000gで希釈し、3.5重量%塩酸水溶液2400g 中に、撹拌しながらゆっくり添加した。添加後5分間撹拌した後、凝析物をろ別した。

#### (3) 水分分離工程

得られた含水含フッ素エラストマーをさらに1kgの HCFC-141b中にあけ、5分間撹拌し、再びろ別 した。この後このHCFC-141bによる洗浄、ろ別の操作をさらに4回繰り返した。

#### (4) 乾燥工程

60℃で72時間真空乾燥させ、58gのエラストマーを得た。

<sup>19</sup> F N M R 分析の結果、このエラストマーのモノマー単位組成は、 T F E / P M V E / C N V E = 5 7 . 3 / 4.1 . 5 / 1 . 2 モル%であった。

このエラストマーの金属成分含有量を実施例1と同様に調べた結果、Fe=180ppb、Cr=30ppb、Ni=1100ppb、Cu=260ppb、Na=1760ppb、K=340ppb、Ca=350ppb、Mg=160ppb、Zn=240ppbおよびAl=30ppbであり、合計4450ppbであった。

# 産業上の利用可能性

本発明によれば、含フッ素エラストマーの金属成分含有量を内部から本質的に低減化することができ、さらに金属成分含有量が充分に低減された含フッ素エラストマーからなる成形品を提供することができる。

# 請求の範囲

- 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーを乳化重合させる際に金属化合物を配合しない含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 2. 金属化合物を用いない含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いるガス状のモノマーを除く原材料のうち少なくとも 1つの原材料を、実質的に金属成分を含まない原材料 とする含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 3. 含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が重合媒体用の水である請求の範囲第 2 項に記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 4. 含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析用の凝析剤である請求の範囲第2項に記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 5. 含フッ素モノマーの重合、凝析、乾燥に用いる原材料が凝析してえられる含水含フッ素エラストマーから水分を分離する際に添加する該含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤である請求の範囲第2項に記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 6. 含フッ素エラストマーの製造において、乳化液を弱アルカリ性に保持して含フッ素エラストマーの乳化重合を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 7. 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エ ラストマーの乳化分散液を濾過して汚染物質を除去し

たのちに凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。

- 8. 含フッ素エラストマーの製造において、金属元素を含まない酸を用いて含フッ素エラストマーの乳化分散液の凝析を行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 9. 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマーに、該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 10. 含フッ素エラストマーの製造において、含フッ素エラストマーの乳化分散液を凝析してえられる含水含フッ素エラストマー、または該含水含フッ素エラストマーに親和性を有する非水溶性溶剤を添加して水分を分離してえられるエラストマー凝析物を、清浄なガスを用いて乾燥させる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 11. 含フッ素エラストマーの製造において、エラストマー凝析物と接触する部分がフッ素樹脂製フィルムまたはポリエチレン製フィルムをラミネートした容器、フッ素樹脂製容器およびポリエチレン樹脂製容器を用いる請求の範囲第10項記載の含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 12. 請求の範囲第1項~第11項に記載の方法のうち少なくとも2つの方法からなる含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。
- 13. 金属化合物を用いない含フッ素エラストマーの製造

• • • • • •

において、含フッ素モノマーの重合、凝析および乾燥に用いるすべての原材料に実質的に金属成分を含まない原材料を用い、乳化液、乳化分散液および凝析後の含水含フッ素エラストマーと接触する部分がフッ素樹脂またはポリエチレン樹脂で作製されているかまたはライニングされている装置を用い、かつ乾燥を清浄なガスを用いて行なう含フッ素エラストマーの金属含有量低減化方法。

- 14. 金属含有量が50ppm以下の含フッ素エラストマー。
- 15. 金属含有量が 1 0 p p m 以下の含フッ素エラストマー。
- 16. 請求の範囲第1項~第13項のいずれかに記載の方法の1つまたは2つ以上を組合せてえられる金属含有量が50ppm以下の含フッ素エラストマー。
- 17. 請求の範囲第1項~第13項のいずれかに記載の方法の1つまたは2つ以上を組合せてえられる金属含有量が10ppm以下の含フッ素エラストマー。
- 18. テトラフルオロエチレン40~90モル%、式(1):  $CF_2 = CF OR$ ,

(式中、R、は炭素数1~5のパーフルオロアルキル基、または炭素数3~12でかつ酸素原子を1~3個含むパーフルオロアルキル(ポリ)エーテル基)で表されるパーフルオロビニルエーテル10~60モル%、および硬化部位を与える単量体0~5モル%からなる請求の範囲第14項に記載の含フッ素エラストマー。

19. ビニリデンフルオライド30~90モル%、ヘキサフルオロプロピレン15~40モル%およびテトラフ

ルオロエチレン 0 ~ 3 0 モル% からなる請求の範囲第 1 4 項に記載の含フッ素エラストマー。

20. ビニリデンフルオライド10~90モル%、式(1): CF<sub>2</sub>=CF-OR<sub>4</sub>

(式中、R<sub>f</sub>は炭素数 1 ~ 5 のパーフルオロアルキル基、または炭素数 3 ~ 1 2 でかつ酸素原子を 1 ~ 3 個含むパーフルオロアルキル(ポリ)エーテル基)で表されるパーフルオロビニルエーテル 1 0 ~ 4 0 モル % およびテトラフルオロエチレン 0 ~ 8 0 モル % からなる請求の範囲第 1 4 項に記載の含フッ素エラストマー。

21. エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントと非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントを有する含フッ素多元セグメント化ポリマーであって、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン40~90モル%、式(1):

 $C F_2 = C F - O R_1$ 

(式中、R<sub>x</sub>は炭素数 1 ~ 5 のパーフルオロアルキル基、または炭素数 3 ~ 1 2 でかつ酸素原子を 1 ~ 3 個含むパーフルオロアルキル(ポリ)エーテル基)で表されるパーフルオロビニルエーテル 1 0~ 6 0 モル%、および硬化部位を与える単量体 0~ 5 モル% からなり、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが、テトラフルオロエチレン 8 5~ 1 0 0 モル%、式(2): CF<sub>2</sub>=CF-R<sub>x</sub><sup>1</sup>

(式中、 $R_1$  は  $C_1$  は  $C_2$  または  $O_3$  R  $R_2$  は 炭素数  $1 \sim 5$  の パーフルオロアルキル基))  $0 \sim 1$  5 モル% からなる請求の範囲第 1 4 項に記載の含フッ素エラストマ

- 22. 末端および/または側鎖にヨウ素および/または臭素を有するポリマー鎖を含む請求の範囲第18項~第21項のいずれかに記載の含フッ素エラストマー。
- 23. ニトリル基を含む請求の範囲第18項~第21項の いずれかに記載の含フッ素エラストマー。
- 24. 請求の範囲第14項~第23項のいずれかに記載の 含フッ素エラストマーを含む組成物。
- 25. 請求の範囲第24項に記載の組成物からなる成形品。
- 26. 金属含有量が50ppm以下である請求の範囲第25項に記載の成形品。
- 27. 金属含有量が 1 0 p p m 以下である請求の範囲第 25 項に記載の成形品。
- 28. 半導体製造装置用シール材である請求の範囲第25項~第27項のいずれかに記載の成形品。
- 29. 請求の範囲第 2 5 項 ~ 第 2 8 項のいずれかに記載の成形品が組み込まれた半導体製造装置。
- 30. 含フッ素ポリマーの製造において、重合用原材料および生成物と接触する部分がフッ素樹脂またはポリエチレン樹脂でライニングされた装置を用いる含フッ素ポリマーの金属含有量低減化方法。
- 31. フッ素樹脂でライニングされた装置が、重合槽およびそれに付属する撹拌翼、邪魔板などの重合装置、凝析装置、洗浄装置、乾燥装置、およびこれらの配管類である請求の範囲第30項に記載の含フッ素ポリマーの金属含有量低減化方法。
- 32. フッ素樹脂がテトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル) 共重合体である請求の範囲第30項に記載の含フッ素ポリマーの金属含有量

低減化方法。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/01517

		j	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 <sup>6</sup> C08F14/18, C08F2/00, C08F	6/00		
	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC		
	S SEARCHED			
	ocumentation searched (classification system followed C1 <sup>6</sup> C08F14/18, C08F2/00, C08F			
Jitsı	tion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1926–1999 i Jitsuyo Shinan Koho 1971–1999	e extent that such documents are include Toroku Jitsuyo Shinan Koh		
Electronic d	lata base consulted during the international search (nan	ne of data base and, where practicable, so	earch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relevant to claim No.	
X Y	JP, 9-500163, A (E.I. Du Por 7 January, 1997 (07. 01. 97) Claims; page 5, line 6 to pag lines 13 to 24 & WO, 9502634, Al & EP, 70	, e 6. line 22 ; page 10,	14-20, 22-29 1-13, 21, 30-32	
X Y	WO, 97/08239, Al (Morisei Ka 6 March, 1997 (06. 03. 97), Claims	14-18, 20, 24-29 1-13, 19, 21-23, 30-32		
X Y	JP, 9-183812, A (Dyneon GmbH 15 July, 1997 (15. 07. 97), Claims; page 2, right column page 3, left column, line 30 line 6; page 3, right column, column, line 12 & EP, 780403, A2 & US, 586	n, lines 22 to 28; to right column, line 43 to page 4, left	1-2, 14-18, 24-27 .3-13, 19-23, 28-32	
X Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
"A" docum- conside "E" earlier "L" docum- cited to special "O" docum- means "P" docum- the prio	ent published prior to the international filing date but later than ority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family		
22 J	actual completion of the international search June, 1999 (22. 06. 99)	Date of mailing of the international sea 6 July, 1999 (06.		
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile N	No.	Telephone No.		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

# . INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/01517

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*		
Salegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  JP, 51-31789, A (Dynamit Nobel AG.),	Relevant to claim No
X Y	18 March, 1976 (18. 03. 76), Claims; page 1, lower right column, lines 12 to 19 & US, 3997705, A	1-2, 4, 8 3, 5-7, 9-32
X Y	JP, 62-285906, A (Daikin Industries, Ltd.), 11 December, 1987 (11. 12. 87), Claims (Family: none)	1, 5, 9 2-4, 6-8, 10-32
X Y	JP, 55-29519, A (Asahi Glass Co., Ltd.), 1 March, 1980 (01. 03. 80), Claims; page 4, lower left column, line 10 to page 5, upper left column, line 16 (Family: none)	1, 6 2-5, 7-32
X Y	JP, 7-179508, A (Ausimont S.p.A.), 18 July, 1995 (18. 07. 95), Claims & EP, 648787, A1 & US, 5608020, A	1, 6 2-5, 7-32
X Y	JP, 1-197510, A (Dainippon Ink & Chemicals, Inc.), 9 August, 1989 (09. 08. 89), Claims; page 2, upper left column, line 9 to upper right column, line 17 (Family: none)	1 2-32
Y	JP, 37-12536, B1 (Imperial Chemical Industries PLC.), 31 August, 1962 (31. 08. 62), Claims	<b>7</b>
Y	JP, 59-59764, A (Daikin Industries, Ltd.), 5 April, 1984 (05. 04. 84), Claims; page 2, upper right column, line 12 to lower left column, line 20 (Family: none)	21
Y	JP, 60-240713, A (E.I. Du Pont de Nemours & Co.), 29 November, 1985 (29. 11. 85), Claims; page 3, upper right column, lines 2 to 11; page 5, upper right column, line 16 to lower right column, line 10 & CA, 1248292, A	1-32
	. :	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>6</sup> C08F14/18, C08F2/00, C08F6/00 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. C1° C08F14/18, C08F2/00, C08F6/00 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1999年 日本国公開実用新案公報 1971-1999年 日本国登録実用新案公報 1994-1999年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 JP, 9-500163, A (イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌム X Y -ル・アンド・カンパニー) 14-20, 22-29 7. 1月. 1997 (07. 01. 97), 特許請求の範囲, 第5頁6行目-第6頁22行目, 第10頁13-24行目&WO, 9502634, A1&EP, 708797, A1 1-13, 21, 30-32 WO, 97/08239, A1 (株式会社森清化工) 6. 3月. 1997 (06. 03. 97), X 14-18, 20, 24-特許請求の範囲 29 Y 1-13, 19, 21-23, 30-32 区欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 論の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 0 6.07.99 22.06.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9062 4 J 日本国特許庁(ISA/JP) 原 賢一 FD: 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3495

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP, 9-183812, A (デユネオン・ゲゼルシヤフト・ミト・ベシユレンクテル・ハフツング) 15. 7月, 1997 (15. 07. 97), 特許請求の範囲, 第2頁右欄22-28行目, 第3頁左欄30行目 -右欄6行目, 第3頁右欄43行目-第4頁左欄12行目&EP, 780403, A2&US, 5861464, A	1-2, 14-18, 24 -27 3-13, 19-23, 28-32
X Y	JP, 51-31789, A (デイナミート・ノーベル・アクチエンゲゼルシヤフト) 18.3月.1976 (18.03.76), 特許請求の範囲,第1頁右下欄12-19行目&US,39977 05, A	1-2, 4, 8 3, 5-7, 9-32
X	JP, 62-285906, A (ダイキン工業株式会社) 11. 12月. 1987 (11. 12. 87), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1, 5, 9 2-4, 6-8, 10- 32
X Y	JP, 55-29519, A(旭硝子株式会社) 1.3月.1980(01.03.80), 特許請求の範囲,第4頁左下欄10行目-第5頁左上欄16行目 (ファミリーなし)	1, 6 2-5, 7-32
X Y	JP, 7-179508, A (オーシモント エス. ピー. エー.) 18. 7月. 1995 (18. 07. 95), 特許請求の範囲&EP, 648787, A1&US, 560802 0, A	1, 6 2-5, 7-32
X Y	JP, 1-197510, A (大日本インキ化学工業株式会社) 9.8月.1989 (09.08.89), 特許請求の範囲,第2頁左上欄9行目-右上欄17行目 (ファミリーなし)	1 2-32
Y	JP, 37-12536, B1 (イムペリアル. ケミカル. インダストリイス. リミテツド) 31. 8月. 1962 (31.08.62), 特許請求の範囲	7
Y	JP, 59-59764, A (ダイキン工業株式会社) 5. 4月. 1984 (05. 04. 84), 特許請求の範囲, 第2頁右上欄12行目-左下欄20行目 (ファミリーなし)	21
. Y	JP, 60-240713, A (イー・アイ・デュポン・デ・ニモアス・アンド・カンパニー) 29. 11月. 1985 (29. 11. 85), 特許請求の範囲,第3頁右上欄2-11行目,第5頁右上欄16行目-右下欄10行目&CA, 1248292, A	1-32
. :		

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)